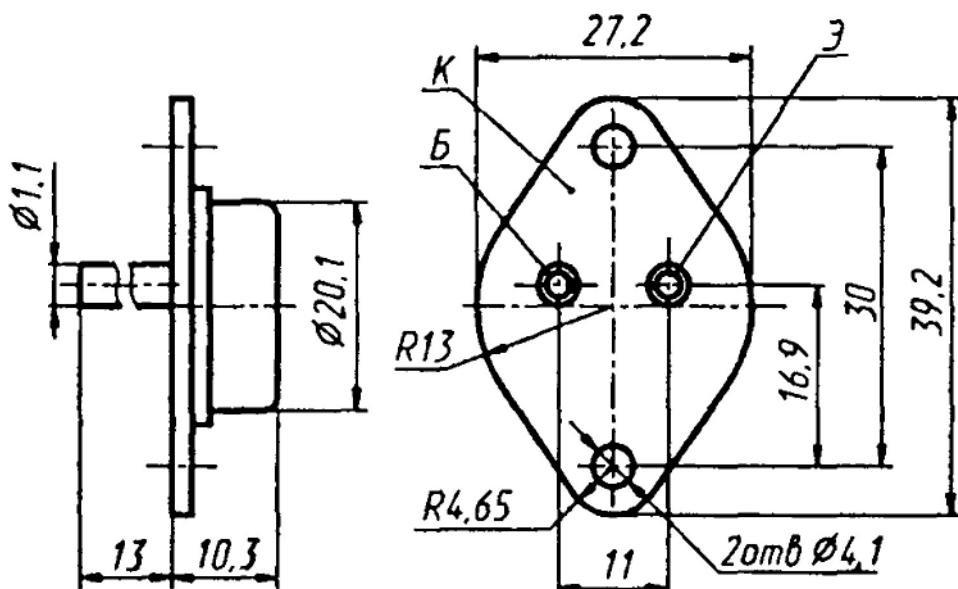


## 2T877A, 2T877Б, 2T877В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры  $p-n-p$  составные универсальные. Предназначены для применения в усилительных и переключающих устройствах. Выпускаются в металлическом корпусе с жесткими выводами и стеклянными изоляторами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 20 г.

2T877(A-B)



### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока  
в схеме ОЭ при  $U_{КБ} = 10$  В,  $I_B = 10$  А:

2T877А .....	750...10000
2T877Б, 2T877В .....	2500...18000

Граничная частота коэффициента передачи  
тока в схеме ОЭ при  $U_{КЭ} = 5$  В,  $I_K = 3$  А,  
не менее ..... 100 МГц

Граничное напряжение при  $I_K = 0,1$  А,  
не менее:

2T877А .....	80 В
2T877Б .....	60 В
2T877В .....	40 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер  
при  $I_K = 10$  А,  $I_B = 0,04$  А, не более ..... 2 В  
Напряжение насыщения база—эмиттер  
при  $I_K = 10$  А,  $I_B = 0,04$  А, не более ..... 3 В

Время включения при $U_{кэ} = 20$ В, $I_k = 10$ А, $I_b = 0,04$ А, типовое значение .....	0,22* мкс
Время выключения при $U_{кэ} = 20$ В, $I_k = 10$ А, $I_b = 0,04$ А, типовое значение .....	0,75* мкс
Время спада при $U_{кэ} = 20$ В, $I_k = 10$ А, $I_b = 0,04$ А, типовое значение .....	0,3* мкс
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 20$ В, типовое значение .....	830* пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{зб} = 3$ В, типовое значение .....	1300* пФ
Обратный ток коллектор—эмиттер при $U_{кэ} = U_{кэ, \text{ макс}}, U_{зб} = 1,5$ В, не более .....	1 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{зб} = 5$ В, не более .....	5 мА

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:

2T877A .....	80 В
2T877Б .....	60 В
2T877В .....	40 В

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер:

2T877A .....	80 В
2T877Б .....	60 В
2T877В .....	40 В

Постоянное напряжение эмиттер—база .....

5 В

Постоянный ток коллектора .....

20 А

Импульсный ток коллектора при  $t_u = 10$  мс ....

40 А

Постоянный ток базы .....

1,5 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллек-

тора<sup>1</sup> при  $T_k = -60...+25$  °С:

с теплоотводом .....

50 Вт

без теплоотвода .....

3 Вт

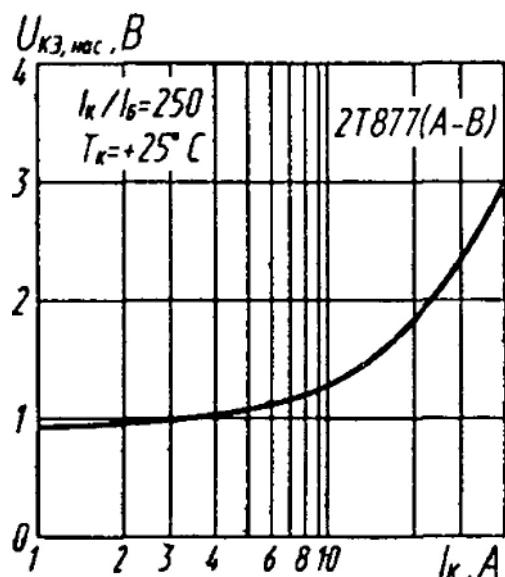
Температура  $p-n$  перехода .....

+175 °С

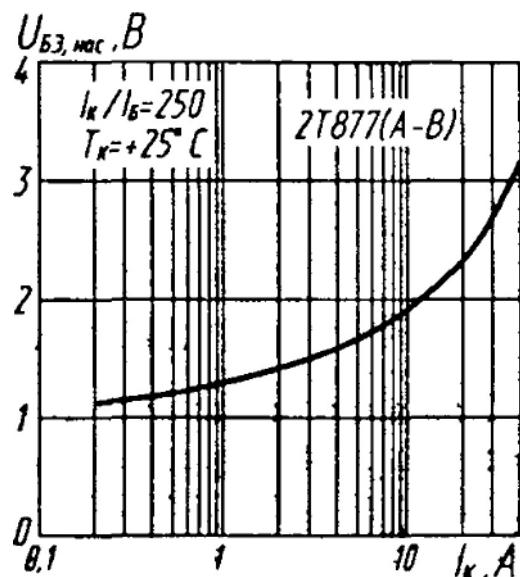
Температура окружающей среды .....

-60... $T_k =$   
= +125 °С

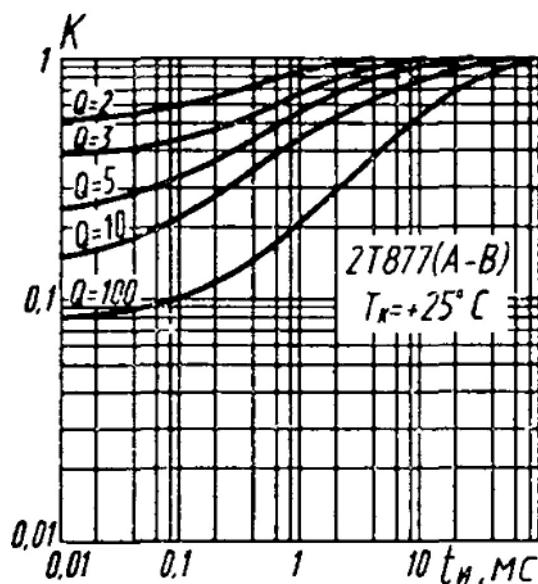
<sup>1</sup> При  $T_k > +25$  °С  $P_{k, \text{ макс}}$  снижается линейно на 0,44 Вт/°С с теплоотводом и на 20 мВт/°С без теплоотвода.



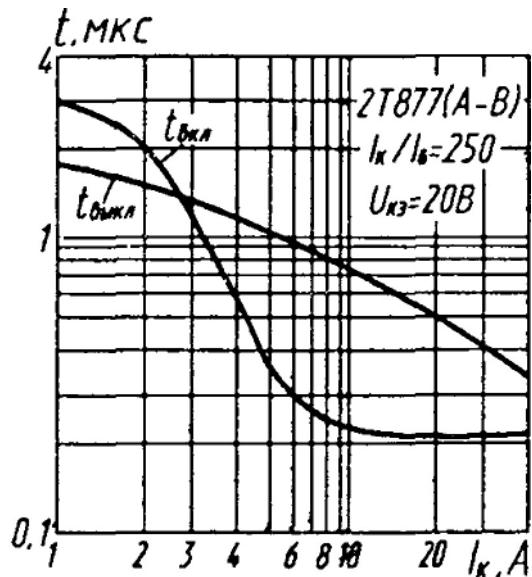
Зависимость напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока коллектора



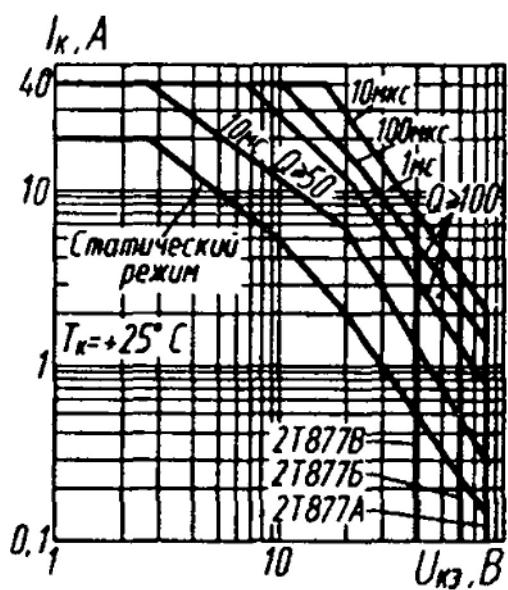
Зависимость напряжения насыщения база—эмиттер от тока коллектора



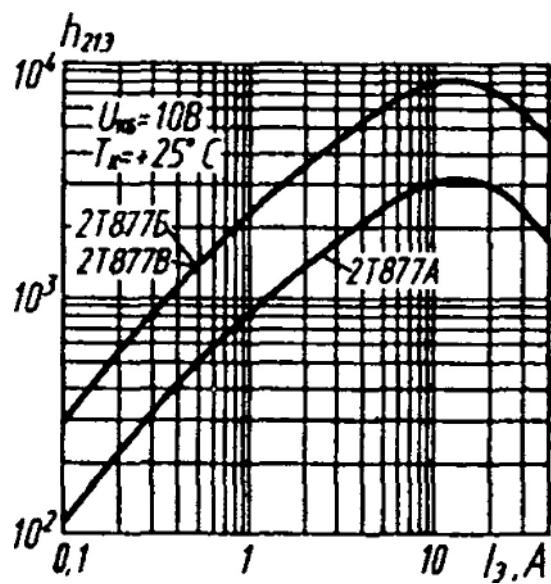
Зависимость коэффициента  $K$  от длительности импульса



Зависимости времени включения и выключения от тока коллектора



Области максимальных режимов



Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера